WEST

End of Result Set

Generate Collection Print JP 10 - 182941

L11: Entry 1 of 1

File: DWPI

Jul 7, 1998

DERWENT-ACC-NO: 1998-434080

DERWENT-WEEK: 199838

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Epoxy! resin compsn. for sealing semiconductor - contains curing agent, inorganic filler contg. alumina, and silicone.

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

TORAY IND INC

TORA

PRIORITY-DATA: 1996JP-0349680 (December 27, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 10182941 A

July 7, 1998

009

C08L063/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 10182941A

December 27, 1996

1996JP-0349680

INT-CL (IPC): C08 G 59/24; C08 K 3/22; C08 K 3/36; C08 L 63/00; C08 L 83/04; H01 L 23/29; H01 L 23/31

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10182941A

BASIC-ABSTRACT:

An epoxy resin compsn. contains (A) epoxy resin, (B) a curing agent, (C) an inorganic filler contg. alumina as the essential component and (D) silicone. The compsn. contains 70-97 wt. % of (C) and (C) contains 0.1-20 wt. % of alumina.

USE - The resin compsn. is suitable for sealing a semiconductor.

ADVANTAGE - The resin compsn. has good flame retardant, soldering heat resistance and high-temp. reliability.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION SEAL SEMICONDUCTOR CONTAIN CURE AGENT INORGANIC FILL CONTAIN ALUMINA SILICONE

DERWENT-CLASS: A21 A26 A85 E33 L03 U11

CPI-CODES: A05-A01E2; A06-A00E2; A07-A03; A07-A03B; A08-D01; A08-R; A12-E04; A12-E07C; E34-C02; L04-C20A;

EPI-CODES: U11-A07;

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平10-182941

(43)公開日 平成10年(1998)7月7日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI
COSL 63/0	0	C 0 8 L 63/00 A
		C
C08G 59/2	4	C 0 8 G 59/24
C08K 3/2	2	C 0 8 K 3/22
3/30	6	3/36
		審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-349680	(71)出顧人 000003159
		東レ株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)12月27日	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者 清水 健
		愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東
		レ株式会社名古屋事業場内
		(72)発明者 一條 力
		愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東
		レ株式会社名古屋事業場内
		(72)発明者 田中 正幸
		愛知県名古屋市港区大江町9番地の1 東
		レ株式会社名古屋事業場内
		レベス会社名 立 医争業場内 <u></u>

(54) 【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 難燃性が高く、また良好な成形性、高い半田 耐熱性、さらに得られた半導体装置において高い信頼性 が与えられる。

【解決手段】 エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無 機質充填剤(C)およびシリコーンを含有する樹脂組成 物であって、無機質充填剤(C)を樹脂組成

【特許請求の範囲】

【請求項1】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、アル ミナを必須成分とする無機質充填剤 (C) およびシリコ ーン(D)を含有する樹脂組成物であって、無機質充填 剤(C)を樹脂組成物中に70~97重量%含有し、さ らにアルミナを無機質充填剤(C)に対して0.1~2 0重量%含有するエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】無機質充填剤(C)の含有量が、組成物全 体の82~97重量%である請求項1記載のエポキシ樹 脂組成物。

*【請求項3】 無機質充填剤 (C) がさらにシリカを含 有することを特徴とする請求項1記載のエポキシ樹脂組 成物。

【請求項4】 シリカの含有量が、無機質充填剤 (C) の80~99.9重量%である請求項3記載のエポキシ 樹脂組成物。

【請求項5】 エポキシ樹脂(A)が下記式(I)の構 造を有するビフェニル型エポキシ樹脂 (a) を必須成分 とする請求項1記載のエポキシ樹脂組成物。

(ただし、式中のR1 ~R8 は、水素原子、炭素数1~ 4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)。

【請求項6】エポキシ樹脂が硬化した後のエポキシ樹脂 20 組成物の難燃性がUL規格において、V-0である請求 項1記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項7】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、アル ミナを必須成分とする無機質充填剤 (C) およびシリコ ーン(D)を含有する樹脂組成物であって、無機質充填 剤(C)を樹脂組成物中に87~97重量%含有し、さ らにアルミナを無機質充填剤(C)に対して0.1~5 0重量%含有するエポキシ樹脂組成物。

※(C)の1~50重量%である請求項7記載のエポキシ 樹脂組成物。

【請求項9】 無機質充填剤(C)がさらにシリカを含 有することを特徴とする請求項7記載のエポキシ樹脂組

【請求項10】 シリカの含有量が、無機質充填剤 (C)の50~99.9重量%である請求項9記載のエ ポキシ樹脂組成物。

【請求項11】 エポキシ樹脂(A)が下記式(I)の 構造を有するピフェニル型エポキシ樹脂 (a) を必須成 分とする請求項7記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項8】 アルミナの含有量が、無機質充填剤 × 【化2】 R2 **R3** RI **R4** CH2-CH-CH2 O OCH2 CH-CH2 (1) n R7 R6

(ただし、式中のR1~R8 は、水素原子、炭素数1~ 4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)。

【請求項12】エポキシ樹脂が硬化した後のエポキシ樹 脂組成物の難燃性がUL規格において、V-0である請 40 およびシリコーン(D)を溶融混合することを特徴とす 求項7記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項13】 半導体封止用であることを特徴とする 請求項1~12いずれかに記載のエポキシ樹脂組成物。

【請求項14】 請求項1~12のいずれかのエポキシ 樹脂組成物で半導体素子を封止してなる半導体装置。

【請求項15】 エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、 アルミナを0.1~20重量%含有する無機質充填剤 (C) (樹脂組成物全体に対して70~97重量%) お よびシリコーン (D) を溶融混合することを特徴とする エポキシ樹脂組成物の製造方法。

★【請求項16】 エポキシ樹脂 (A)、硬化剤 (B) お よびアルミナを0.1~50重量%含有する無機質充填 剤(C)(樹脂組成物全体に対して87~97重量%)

るエポキシ樹脂組成物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、難燃性、半田耐熱 性および高温信頼性に優れるエポキシ樹脂組成物、詳し くは半導体封止用エポキシ樹脂組成物および半導体装置 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体装置などの電子回路部分の封止方 ★50 法としては、経済性、生産性、物性のバランスの点か

ら、エポキシ樹脂、硬化剤、無機質充填剤からなる封止 用樹脂を用いた封止方法が中心になっている。近年の半 導体装置の薄型・高密度化により、半導体装置に対する 半田耐熱性・高温信頼性などの要求は高まっており、そ れに従って封止用樹脂への要求もより高まっている。

【0003】これら半導体などの電子部品には安全性確 保のために、UL規格により難燃性の付与が義務づけら れている。このため封止用樹脂にはこれまでに、難燃剤 として臭素化エポキシ樹脂などのハロゲン化ポリマ、ま た難燃助剤として三酸化アンチモンなどのアンチモン化 10 合物が添加されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年、環境問題に対す る意識が高まってきており、半導体封止用樹脂に難燃剤 として使用される種々の化合物に対しても関心が高まっ ている。

【0005】例えばハロゲン化ポリマ系難燃剤は燃焼時 にハロゲン化ガスを発生することが指摘されている。ま た、高温環境下では、難燃剤に起因するハロゲンが、半 導体の配線の腐蝕を促進し、半導体装置の信頼性を低下 20 させる要因と考えられている。

【0006】またアンチモン化合物を含有させた場合、 使用済の封止用樹脂の廃棄物処理の問題などが憂慮され ている。

【0007】 したがってこれらハロゲン化ポリマーや酸 化アンチモンは必要最低限の添加量にすることが望まれ ている。

【0008】なお、本発明は特定量のアルミナを無機充 填剤の一部として使用することにより難燃性が付与され るという特徴を有するものであるが、アルミナを無機充 30 填剤の一部としてエポキシ樹脂組成物に配合した文献と しては、特開昭63-70446号公報、特開昭63-183915 号公 報があるが、これらのアルミナの配合の目的は、半導体 素子からの発熱を発散させるために、エポキシ樹脂組成 物に配合するものであり、難燃性については記載がな 11

【0009】本発明は、上記の課題に対して、難燃性、 高温信頼性に優れ、従来の難燃剤を必ずしも必要としな いエポキシ樹脂組成物、特に半導体用封止用途のエポキ* *シ樹脂組成物の提供を課題とするものである。 [0010]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、エ ポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機質充填剤

(C) およびシリコーン (D) を含有する樹脂組成物で あって、無機質充填剤(C)を樹脂組成物中に70~9 7重量%含有し、さらに無機質充填剤(C)がアルミナ を0.1~50重量%含有するエポキシ樹脂組成物であ り、さらに好ましくは無機質充填剤 (C) が樹脂組成物 中で70~97重量%であり、かつ無機質充填剤(C) がアルミナを0.1~20重量%含有する組成物、また は無機質充填剤(C)が樹脂組成物中で87~97重量 %であり、さらに無機質充填剤(C)がアルミナをO. 1~50重量%含有する組成物である。

【0011】さらに、本発明は、これら上記のエポキシ 樹脂組成物で半導体素子を封止してなる半導体装置であ り、また上記組成のエポキシ樹脂組成物を溶融混合する ことを特徴とするエポキシ樹脂組成物の製造方法であ

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を詳述する。 本発明において重量とは質量を意味する。

【0013】本発明におけるエポキシ樹脂 (A) は分子 内にエポキシ基を複数個もつものならば特に限定され ず、それらの具体例としては、たとえばビフェニル型エ ポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フ ェノールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールA 型エポキシ樹脂、ビスフェノールAやレゾルシンなどか ら合成される各種ノボラック型エポキシ樹脂、直鎖脂肪 族エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、複素環式エポキ シ樹脂などがあげられる。

【0014】これらのエポキシ樹脂 (A) のなかで特に 本発明において好ましく使用されるものは、ハンダ耐熱 性および成形性が優れているという点で、下記一般式 (1)で表される骨格を有するビフェニル型エポキシ樹 脂(a)を必須成分として含有するものである。

[0015]

【化3】

(ただし、式中のR1 ~R8 は、水素原子、炭素数1~ 4のアルキル基またはハロゲン原子を示す)。

【0016】そして、エポキシ樹脂 (A) は、一般式

※脂を50重量%以上、特に70重量%以上含有すること が好ましい。

【0017】上記式(I)で表されるエポキシ樹脂骨格 (I) で表される骨格を有するビフェニル型エポキシ樹%50 の好ましい具体例としては、4, 4 - ビス (2, 3 -

エポキシプロポキシ) ビフェニル、4,4 - ービス (2, 3-エポキシプロポキシ) -3, 3⁻, 5, 5⁻ テトラメチルビフェニル、4,4 ービス(2,3-エ ポキシプロポキシ) -3, 3^{-} , 5, 5^{-} - テトラメチ N-2-2チルー2ープロモビフェニル、4,4 - ビス(2,3 -**L** $x^{2}+y^{2}$ **L** $y^{2}-x^{2}+y^{2}$ **L** エチルビフェニル、4,4 - ピス(2,3-エポキシ プロポキシ) -3, 3^{-} , 5, 5^{-} - 7 7 7 7 10ェニル、4,4 - ービス(2,3-エポキシプロポキ シ) ビフェニル、および4,4 ービス(2,3-エポ キシプロポキシ)-3,3^{*},5,5^{*}ーテトラメチル ビフェニルなどが挙げられる。これらエポキシ樹脂はそ の重合体を含むことができる。これらはそれぞれ単独で も、または混合系で用いる場合でも十分に効果を発揮す

【0018】エポキシ樹脂 (A) においては2種類以上 のエポキシ樹脂を併用して含有することができる。また これらのエポキシ樹脂は、エポキシ基の開環反応によっ*20

*て重合したものも含まれる。

【0019】本発明において、エポキシ樹脂(A)の配 合量は、成形性および接着性の観点から、エポキシ樹脂 組成物において、通常0.05~25重量%、好ましく は2~15重量%、さらに好ましくは2~10重量%。 さらには2~8重量%である。

【0020】本発明における硬化剤 (B) は、エポキシ 樹脂(A)と反応して硬化させるものであれば特に限定 されない。通常はフェノール性水酸基を有する化合物、 酸無水物を有する化合物、アミン類が使用される。これ らのうち、フェノール性水酸基を有する化合物の具体例 としては、たとえばフェノールノボラック樹脂、クレゾ ールノボラック樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ビス フェノールAやレゾルシンなどから合成される各種ノボ ラック樹脂、トリス(ヒドロキシフェニル)メタン、ジ ヒドロビフェニル、下記式(II)で示されるフェノールp -キシリレンコポリマーなどの多価フェノール化合物、 ポリビニルフェノールが例示される。

【化4】

... (11)

(上式において、nはO以上の整数。ベンゼン環はメチ (...

【0021】また酸無水物を有する化合物としては無水 マレイン酸、無水フタル酸、無水ピロメリット酸などが 例示される。またアミン類としてはメタフェニレンジア ミン、ジ (アミノフェニル) メタン (通称ジアミノジフ ェニルメタン)、ジアミノジフェニルスルホンなどの芳 香族アミンなどが例示される。半導体封止用としては耐 熱性、耐湿性および保存性の点から、フェノール系硬化 剤が好ましく用いられ、用途によっては2種類以上の硬 化剤を併用してもよい。

【0022】本発明において、硬化剤(B)の配合量 は、通常1~20重量%、好ましくは1~10重量%で ある。さらには、エポキシ樹脂 (A) と硬化剤 (B) の 配合比は、機械的性質、および耐湿信頼性の点から (A) に対する(B) の化学当量比が0.5~1.5、 特に0.8~1.2の範囲にあることが好ましい。 【0023】また本発明においてエポキシ樹脂(A)と 硬化剤(B)の硬化反応を促進するために硬化触媒を用 いてもよい。硬化触媒は硬化反応を促進するものならば

※2,4-ジメチルイミダゾール、2-エチルー4-メチ ルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、2ーフェ ル基、エチル基などのアルキル基で置換されていてもよ 30 ニルー4-メチルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミ ダゾールなどのイミダゾール化合物、トリエチルアミ ン、ベンジルジメチルアミン、α-メチルベンジルジメ チルアミン、2-(ジメチルアミノメチル)フェノー ル、2, 4, 6 - トリス (ジメチルアミノメチル) フェ ノール、1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデ センー7などの三級アミン化合物、ジルコニウムテトラ メトキシド、ジルコニウムテトラプロポキシド、テトラ キス (アセチルアセト) ジルコニウム、トリ (アセチル アセト) アルミニウムなどの有機金属化合物およびトリ 40 フェニルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリエチ ルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリ (p-メチ ルフェニル) ホスフィン、トリ (ノニルフェニル) ホス フィンなどの有機ホスフィン化合物があげられる。なか でも耐湿性の点から、有機ホスフィン化合物が好ましく 用いられる。これらの硬化触媒は、用途によっては2種 類以上を併用してもよく、その添加量は、エポキシ樹脂 (A) 100重量部に対して0.1~10重量部の範囲 が好ましい。

【0024】本発明においては無機質充填剤(C)は樹 特に限定されず、例えば、2-メチルイミダゾール、850 脂組成物中に $70\sim97$ 重量8含有し、さらに無機質充

填剤(C)がアルミナを0.1~50重量%含有するこ とが特徴であるが、難燃性および成形性が良好であると いう観点から、第1の組成として、無機質充填剤(C) が樹脂組成物中で70~97重量%であり、かつ無機質 充填剤(C)がアルミナを0.1~20重量%含有する もの、/また第2の組成として無機質充填剤(C)が樹 脂組成物中で87~97重量%であり、さらに無機質充

のことである。

填剤(C)がアルミナを0.1~50重量%含有する組

成物である。

【0026】難燃性、成形性の観点から、無機質充填剤 (C) 中にアルミナの量は、前に示した量が配合できる が、さらに成形性、難燃性などの観点から、好ましく は、1~20重量%、さらに、1~18重量%、またさ らに1~10重量%、また加えて1~9重量%の量が好 ましい。

【0027】無機質充填剤 (C) において、アルミナ以 外の無機質充填剤として、シリカすなわち二酸化ケイ素 が好ましく配合される。シリカの含有量としては無機充 20 填剤(C)において、50~99.9重量%、52.9 ~99重量%さらに80~99重量%、さらに90~9 9重量%の配合が好ましい。

【0028】このような無機質充填剤としては、アルミ ナおよびシリカが粒子中に共存したものや、アルミナを 50重量%以上含有する粒子およびシリカを50重量% 以上含有する粒子を併用した粒子混合物が使用できる。 なかでも、各種特性への効果から、後者の粒子混合物の 形態が好ましく使用され、実質的にアルミナを主成分と するアルミナ粒子およびシリカを主成分とするシリカ粒 30 子の混合によるものがさらに好ましい。

【0029】アルミナを主成分とする粒子としてはは、 その結晶構造により、 α , γ , δ , θ 型などがあり、任 意のものが使用でき、またこれらのうち複数を併用して もよいが、熱・化学的安定性からαーアルミナが好まし く用いられる。本発明におけるαーアルミナの製造法は 任意の方法を用いることができる。例えば、①ボーキサ イトからバイヤー法により得られた水酸化アルミニウム を焼成し、アルミナとする方法、2各種のアルミニウム 塩から得た水酸化アルミニウムを焼成しアルミナとする 40 方法、3金属アルミニウム粉末を爆燃(VMC:Vaporri zed Metal Combustion) 法により酸化させてアルミナを 得る方法があげられる。本発明で好ましく用いられるア ルミナとしては、組成物の成形時の流動性の観点から、 溶融球状化されているものが好ましい。またアルミナへ 焼成する段階で特定のプロセスにより、粒径、粒子形状 などが調節されていることが、難燃性および流動性の観 点から好ましい。

【0030】シリカ粒子としては、非晶性シリカ、結晶

膨張係数を低下させる効果が大きく、低応力化に有効な ため好ましく用いられる。非晶性シリカの粒子は任意の 製造方法で製造することができる。例えば結晶性シリカ を溶融する方法、各種原料から合成する方法などがあげ られる。

【0031】本発明における無機質充填剤、ならびに無 機質充填剤に配合されるアルミナ粒子およびシリカ粒子 の形状および粒径は特に限定されないが、それぞれ平均 粒径3μm以上40μm以下の球状粒子を無機質充填剤 【0025】ここでいうアルミナとは酸化アルミニウム 10 中に60重量%以上、さらに好ましくは90重量%以上 含有することが流動性の点から好ましい。

> 【0032】ここでいう平均粒子径は累積重量50%に なる粒径 (メジアン径)を意味する。

> 【0033】本発明において無機質充填剤の(C)の割 合は、前に示したとおりであるが、難燃性、成形性およ び低応力性の点から、好ましくは80~97重量%さら に好ましくは85~97重量%、87~97重量%、8 7~95重量%である。

【0034】本発明において、無機質充填材をシランカ ップリング剤、チタネートカップリング剤、アルミネー トカップリング剤などのカップリング剤であらかじめ表 面処理することが、半導体素子をエポキシ樹脂組成物で 封止した半導体装置の信頼性が高まるという点で好まし

【0035】シランカップリング剤とは、アルコキシ 基、ハロゲン原子、アミノ基などの加水分解性基および 有機基がケイ素原子に直結したもの、およびその部分加 水分解縮合物が一般的に用いられる。加水分解性の基と してはアルコキシ基、なかでも、メトキシ基、エトキシ 基が好ましく用いられる。有機基としては、炭化水素基 や窒素原子、酸素原子、ハロゲン原子、硫黄原子などに よって置換された炭化水素基のものが使用され、さらに 上記原子によって置換された炭化水素基が好ましく使用 される。とくに置換された炭化水素基としては、エポキ シ基を持つものや、アミノ基を持つものが好ましく使用 される。なかでも2級アミノ基をもつもの、さらにアミ ノ基すべてが2級アミノ基のものが好ましく使用され る。シランカップリング剤としては以下のものが例示さ れる。

【0036】エポキシ基が結合した有機基を有するシラ ンカップリング剤としてケーグリシドキシプロピルトリ メトキシシラン、アーグリシドキシプロピルメチルジメ トキシシシラン、 γ -(2,3-エポキシシクロヘキシ ル) プロピルトリメトキシシラン。

【0037】アミノ基を有するものとして、N-β-**(アミノエチル)~~~アミノプロピルトリメトキシシ** ラン、N-β-(アミノエチル)-γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N-β- (アミノエチル) -性シリカなどがあげられるが、非晶性シリカの粒子は線 50 ピルトリエトキシシラン、アーアミノプロピルメチルジ

10

エトキシシラン、r-アミノプロピルトリメトキシシラン、r-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、r-(N, N-ジメチルアミノ) プロピルトリメトキシシラン、r-(N-フェニルアミノ) プロピルトリメトキシシラン、r-(N-フェニルアミノ) プロピルメチルジメトキシシラン、r-(N-メチルアミノ) プロピルトリメトキシシラン、r-(N-メチルアミノ) プロピル)メチルジメトキシシラン、r-(N-エチルアミノ) プロピルトリメトキシシラン、およびr-(N-エチルアミノ) プロピルメチルジメトキシシラン。

【0038】その他のものとして、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、アーメタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、アーメルカトプロピルトリメトキシシラン、アーメルカトプロピルメチルジメトキシシラン。

【0039】本発明においては、半田耐熱性付与のために、シリコーンが添加される。シリコーンとは、ポリオルガノシロキサンであり、一般的には、ジメチルシロキサン単位、メチルフェニルシロキサン単位、ジフェニルシロキサン単位を主成分(好ましくは60モル%以上、さらに好ましくは80モル%以上)とするものが好ましく用いられる。また水素、エチル基、水酸基で側鎖または末端が置換したものも使用できる。形態としては、オイル状、ゴム状のものが任意に用いられる。シリコーンの分子量としては、ジシロキサン構造のものから、架橋により無限大となっているものまで任意である。なかでも数平均重合度として、シロキサンの繰返し単位が2以上、さらに5以上、一方、10,000以下、さらに5,000以下、さらに2,000以下のものが好まし30く用いられる。

【0040】シリコーンの配合量としてはエポキシ樹脂(A)および硬化剤(B)の和に対して、0.01~50重量%、さらに0.1~40重量%、さらに1~35重量%の範囲が好ましく配合される。

【0041】シリコーンにおいては、エボキシ基、アミノ基、メルカプト基、カルボキシル基または水酸基が結合した有機基が、一部のケイ素原子の側鎖または重合体の末端に直結した変性シリコーンが使用されることが好ましい。このような有機基としては、アーグリシドキシのプロピル基、アー(2、3ーエボキシシクロヘキシル)プロピル基、アーアミノプロピル基、アーメルカトプロピル基、アーカルボキシプロピル基、アーとドロキシプロピル基などが例示される。またカルボキシル基を有する有機基と、多価エボキシ化合物との反応により、エボキシ基が付与された官能基、アミノ基を有する有機基と、多価アミノ基化合物との反応により、アミノ基が付与された官能基、エボキシ基を有する有機基と、多価アミノ基化合物との反応により、アミノ基が付与された官能基なども有効である。

【0042】本発明において、必須成分ではないがブロム化合物を配合出来る。ブロム化合物は、通常半導体封止用エボキシ樹脂組成物に難燃の目的として添加されるもので、特に限定されない。

【0043】存在するプロム化合物の好ましい具体例としては、プロム化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、プロム化フェノールノボラック型エポキシ樹脂などのプロム化エポキシ樹脂、プロム化ポリカーボネート樹脂、プロム化ポリスチレン樹脂、プロム化ポリフェニレンオキサイド樹脂、テトラブロモビスフェノールA、デカプロモジフェニルエーテルなどがあげられ、なかでも、プロム化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、プロム化フェノールノボラック型エポキシ樹脂などのプロム化エポキシ樹脂が、成形性の点から特に好ましい。

キシシラン。 【0044】本発明の組成物中に存在するプロム化合物 【0039】本発明においては、半田耐熱性付与のため に、シリコーンが添加される。シリコーンとは、ポリオ ルガノシロキサンであり、一般的には、ジメチルシロキ サン単位、メチルフェニルシロキサン単位、ジフェニル シロキサン単位などの重合体であり、なかでもジメチル 20 下、0.07重量%以下、さらに0.04重量%以下が 好ましい。

【0045】本発明では必須成分ではないが、アンチモン化合物を配合することができる。通常半導体封止用エボキシ樹脂組成物に難燃助剤として添加されるもので、特に限定されず、公知のものであってよい。アンチモン化合物の好ましい具体例としては、三酸化アンチモン、四酸化アンチモン、五酸化アンチモンがあげられる。

【0046】本発明組成物中に存在するアンチモン化合物の量は、全体の0.3重量%以下が高温信頼性の点で好ましい。特に好ましくは0.1重量%以下、さらに好ましくは0.05重量%以下、さらには実質的に配合されていないものである。アンチモン原子に注目すると0.25重量%以下、0.075重量%以下、さらに0.0375重量%以下の順に好ましい。

【0047】本発明のエポキシ樹脂組成物においては、 エポキシ樹脂の硬化後の酸素指数が42%以上であるこ とが好ましい。

【0048】ここで酸素指数はJIS K7201に従って、燃焼限界点における各ガス体積濃度を求めた値から次式に従って算出したものをいう。

酸素指数 (%) = [酸素] / ([酸素] + [窒素]) × 100

【0049】さらに、本発明のエポキシ樹脂組成物においては、エポキシ樹脂の硬化後の難燃性がUL94規格においてV-0であることが、難燃性の面から好ましく、さらに、上に説明した臭素原子の含有量またはアンチモン原子の含有量において、V-0であることが好ましい

【0050】本発明のエボキシ樹脂組成物には、カーボ 50 ンブラック、酸化鉄などの着色剤、ハイドロタルサイト などのイオン捕捉材、オレフィン系共重合体、変性ニト リルゴム、変性ポリブタジエンゴム、などのエラストマ ー、ポリエチレンなどの熱可塑性樹脂、長鎖脂肪酸、長 鎖脂肪酸の金属塩、長鎖脂肪酸のエステル、長鎖脂肪酸 のアミド、パラフィンワックスなどの離型剤、先に示し たもの以外の各種ケイ素化合物、および有機過酸化物な どの架橋剤を任意に添加することができる。

【0051】本発明のエポキシ樹脂組成物は溶融混合し て製造することが好ましく、たとえばバンバリーミキサ ー、ニーダー、ロール、単軸もしくは二軸の押出機およ 10 びコニーダーなどの公知の混練方法を用いて通常50~ 170℃、好ましくは70~150℃の温度で溶融混練 することにより製造される。

【0052】本発明のエポキシ樹脂組成物は、通常は粉 末またはタプレット状態で半導体装置の封止に供され る。半導体素子を基板に固定した部材に対して、低圧ト ランスファー成形機を用いて、エポキシ樹脂組成物を、 例えば120~250℃、好ましくは150~200℃ の温度で成形し、エボキシ樹脂組成物の硬化物とするこ とによって、エボキシ樹脂組成物の硬化物によって封止 20 量は表1に記載) された半導体装置が製造される。また必要に応じて追加 熱処理 (例えば150~200℃、2~15時間) も行*

*なうことができる。

【0053】ここで半導体装置とは、トランジスタやダ イオード、抵抗、コンデンサーなどを半導体チップや基 板の上に集積し配線して作った電子回路 (集積回路) の ことを指し、広くは本発明のエポキシ樹脂組成物により 封止した電子部品を指す。

12

[0054]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。なお、実施例中の%は重量%を示す。

【0055】なお、本発明で使用した原材料および、組 成物への配合量は以下のとおりである。

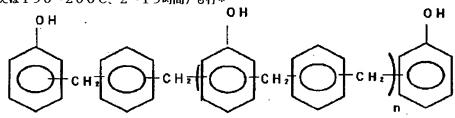
<エポキシ樹脂 I >エポキシ当量200のオルソクレゾ ールノボラック樹脂(配合量は表1に記載)

<エポキシ樹脂II> 4,4'-ビス (2,3-エポキシプロポ キシ) -3,3',5,5'- テトラメチルビフェニル (配合量は 表1に記載)

<硬化剤I> 水酸基当量107のフェノールノボラッ ク樹脂(配合量は表1に記載)

<硬化剤II> 下記に示されるフェノール化合物(配合

【化5】



(ただしnが1~3である成分を約90重量%含む) <無機質充填剤 I > 平均粒径 1 6 μm の球状αーアル ミナ(昭和電工 AS-30)(配合量は表1に記載) <無機質充填剤II>平均粒径15μmの非晶性溶融シリ カ(配合量は表1に記載)

<シリコーンI>. 末端がカルボキシルエチル基である ポリジメチルシロキサン(数平均重合度40)(配合す る場合には0.3重量%)

〈シリコーン[]〉シリコーン[1モルと4, 4 ~ ービス (2, 3-エポキシプロポキシ) ビフェニル2モルとの 反応物。末端はエポキシ基となっている。(配合する場 40 合には0.3重量%)

<シリコーンIII >ヒドロキシプロピル基が側鎖に平均 3個結合しているポリジメチルシロキサン (数平均重合 度24)(配合する場合には0.3重量%)

<シリコーンIV>末端がアミノプロピル基であるポリジ メチルシロキサン(数平均重合度30)(配合する場合 には0.3重量%)

<難燃剤>エポキシ当量400、臭素含有量50重量%※

30%のブロム化ビスフェノールA型樹脂(配合量は表1に記 載)

<難燃助剤>三酸化アンチモン(配合量は表1に記載) <硬化促進剤> トリフェニルホスフィン (0.1重 量%)

<シランカップリング剤>N-フェニルアミノプロピル トリメトキシシラン(シリコーンを配合する場合には 0.7重量%、配合しない場合には1.0重量%)(シ ランカップリング剤は前もって無機充填剤と混合してお いた。)

<着色剤>カーボンブラック(0.2重量%)

<離型剤>カルバナワックス(0.3重量%)

実施例 比較例

各成分を、表1に示した組成比で、ミキサーによりドラ イブレンドした。これを、ロール表面温度90℃のミキ シングロールを用いて5分間加熱混練後、冷却・粉砕し て半導体封止用のエポキシ樹脂組成物を製造した。

[0056]

【表1】

表1

	1	1件/體 動量(重量部)		硬化剂 為關(重量部		充填剤		· 考値)	シリ コーン	難燃剤	建 燃助剤 添加量
	1	п	1	I	· I	11	I+1	Tuith(1)	種類	(wt部)	(重量部)
実施例1	.	8. 87		7. 23	3. 0	79. 0	82. 0	3. 7	I	0.00	0, 00
実施例2		8. 87		7. 23	14.0	68. 0	82.0	17.1	I	0.00	0.00
実施例3		6.11		4. 99	3. 0	84. 0	87. 0	3. 5	I	0.00	0,00
実施例3		6. 11		4.99	3. 0	84. 0	87. 0	3. 5	п	0.00	0.00
実施例3		6. 11		4. 99	3 . d	84. 0	87. Q	3. 5	Ш	0.00	0.00
実施例3		6.11		4.99	3. 0	84. 0	87. Q	3, 5	IA	0.00	0.00
実施例4		6. 11		4.99	15. q	72. 0	87. 0	17. 2	I	0.00	0.00
実施例5		6. 11		4. 99	40. q	47. 0	87. Q	46. 0	I	0.00	0.00
実施例6		5. 41	1. 23	2.46	8. Q	81.0	89. 0	9.0	I	0.00	0.00
実施例7	1. 50	3. 51		4.09	8. q	81. 0	89. Q	9. 0	I	0.00	0.00
実施例8		1.71		1.39	3. q	92. 0	95. 0	3. 3	ī	0.00	0.00
実施例9		1.71		1.39	16. q	79.0	95. 0	16. 9	I	0.00	0.00
実施例10		1.71		1. 39	42 . 0	53. 0	95. 0	44. 2	I	0.00	0.00
比較例1		16.02		13. 08	10.0	59.0	69. 0	14. 5	I	0.00	0.00
比較例2		8. 87		7. 23	0. d	82.0	82. d	0.0	I	0.00	0.00
比較例3		8. 87		7. 23	33. q	59. 0	82. Q	40. 0	ī	0.00	0.00
比較例4	ļ	7. 21		5. 89	0.0	85.0	85. Q	0	I	0.00	0.00
比較例5	.	7. 21		5. 89	50. Q	35.0	85. Q	58. 8	Ī	0.00	0,00
比較例6		6. 11		4. 99	0.0	87. 0	87. Q	0	1	0.00	0.00
比較例7	- [6. 11		4. 99	48.0	39. 0	87. q	55. 2	ı	0.00	0.00
比較例8	İ	1.71		1. 39	0.0	95.0	95. q	0	I	0.00	0.00
比較例9		1.71		1. 39	53. Q	42.0	95. Q	55. 8	I	0.00	0.00
比較例 10		4.46		4. 99	0.0	89.0	89. q	0	I	0.5	0. 5
比較例11		6. 11		5. 12	3.0	84. 0	87. Q	3. 5	_	0.00	0.00

1) アルミナ量: 充塊剤における 【成分の含有量 (重量%)

【0057】この樹脂組成物を用いて、低圧トランスフ ァー成形法により175℃, キュアータイム2分間の条 40 吸水率: 半田耐熱性試験に用いる160pinQFPを 件で成形し、180℃、5時間の条件でポストキュアー して下記の物性測定法により各樹脂組成物の物性を評価 した。なお特に示さない限り成形条件は175℃、キュ アタイム2分間であり、ポストキュアは180℃,5時 間とした。

半田耐熱性:表面にAI蒸着した模擬素子を搭載した、 チップサイズ12×12mmの160pinQFP(ク アッドフラットパッケージ) を20個成形し、85℃/ 85%RTで120時間加湿後、最高温度245℃のI Rリフロー炉で加熱処理し、外部クラックの発生数を調*50 酸素指数: $5" \times 1/2" \times 1/8"$ の試験片を成形・

*べた。

85℃/85%RHで100時間加湿後、樹脂組成物の 吸水率を測定した。

高温信頼性:模擬素子を搭載した16pinDIP (デ ュアルインラインパッケージ)を用い、200℃での高 温信頼性を評価し、累積故障率63%になる時間を求め 高温特性寿命とした。

難燃性試験:5"×1/2"×1/16"の燃焼試験片 を、成形・ポストキュアーし、UL94規格に従い難燃 性を評価した。

15

. . .

16 を成形後に目視および顕微鏡を用いて観

ポストキュアーし、JIS K7201に従い燃焼限界 点における各ガスの体積濃度を求めた。 * Pを成形後に目視および顕微鏡を用いて観察し、未充填・ボイドの有無を調べた。

酸素指数 (%) = [酸素] / ([酸素] + [窒素])

[0058]

PKG充填性: 半田耐熱試験に用いる160pinQF*

【表2】

表2

	形状指摘 (%)	発療性	高温信報性 特性寿命 (b)	PKG 充筑性	半田耐熱性 外部/ラック 発生軟	昭水率 (X)
実施例1	42	v -0	>400	良好	3/20	0. 16
実施例2	46	V-0	>400	良好	4/20	0.17
実施例3	45	V0	>400	良好	0/20	0. 13
実施例4	51	V-0	>400	良好	0/20	9. 16
実施例 5	49	V-0	>400	良好	5/20	0.21
実施例6	52	V-0	>400	良好	0/20	0.14
実施例7	- 53	V-0	>400	良好	0/20	0.14
実施例8	55	A-0	>400	良好	0/20	0.11
実施例9	81	v -0	>400	良好	0/20	0.13
実施例10	59	V-0	>400	良好	4/20	0.18
比較例1	36	V-001	350	朗	20/20	0.34
比較例2	39	V-2	>400	良好	2/20	0.19
比較例3	44	V-1	>400	宴	20/20	0. 25
比较例4	32	V-2	>400	良好	5/20	0.17
比較例5	40	V-1	>400	未充填	20/20	0. 28
比較例6	41	v-1	>400	良好	0/20	0. 13
比较例7	40	V-1	>400	未充填	20/20	0. 25
比較例8	52	V-0	>400	未充填	10/20	0. 12
比較例9	41	V-1	>400	未充填	20/20	0. 23
比较例10	45	V-0	80	良好	3/20	0.12
比较例11	44	v-0	>400	良好	5/20	0. 16

【0059】表1および2に見られるように、本発明の エポキシ樹脂組成物は、難燃性、半田耐熱性、高温信頼 性、PKG充填性に優れている。

【0060】これに対して無機質充填剤(C)の添加量が70%未満である場合や、無機質充填剤(C)の添加量が70%以上であってもアルミナを含有しない場合は難燃性が劣っている。

【0061】また、無機質充填剤(C)中にアルミナの し、また良好な成形性、高い半田耐熱性、さらに量が多すぎる場合には、難燃性および充填性が劣ってい※40 た半導体装置において高い信頼性が与えられる。

%る。

【0062】難燃剤および難燃助剤を含有し、アルミナを含有しない場合には難燃性には優れるが高温信頼性が劣っている。

[0063]

【発明の効果】特定量の無機質充填剤において、特定量のアルミナを含有させることによって、難燃性が向上し、また良好な成形性、高い半田耐熱性、さらに得られた半導体装置において高い信頼性が与えられる

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FI

CO8L 83/04

CO8L 83/04

H01L 23/29

HO1L 23/30

23/31

R